

# 加工

(成膜装置群)

## 酸化 / 拡散炉

dSi社製 VESTA-2100

### 仕様

処 理 物	不定形～4インチウエハ
処 理 能 力	25枚 4.76mmピッチ
最高使用温度	1200° C
温度制御精度	±0.5° C
温度設定分解能	0.1° C
長期安定度	±0.5° C (24 Hour)



## 熱酸化膜形成・電気特性制御

酸化炉は、Dry酸化またはパイロジェニック酸化法によるWet酸化による酸化膜の成膜が可能です。どちらの方式でも導電性イオンの少ない良質な絶縁特性を持った酸化膜が形成できます。拡散炉では、固体不純物源によるp型またはn型半導体シリコン領域の形成が可能です。温度条件により、拡散領域の電気特性を制御することが可能です。

また、両炉ともに加工温度・時間・使用ガスを設定したプログラムによる自動運転が可能です、再現性の高い加工を行うことができます。

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: [nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp](mailto:nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp)